

	<h2>SI3459BDV-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3459BDV-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 2.9A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3459BDV-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 72306 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3459BDV-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 2.9A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	72306 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.3W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	216 mOhm @ 2.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 30V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI3459BDV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3459BDV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3459BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3459BDV-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 SI3459DV-T1 VISHAY SI3459DV-T1 VISHAY	 SI3459-KIT Energy Micro (Silicon Labs) EVAL KIT FOR SI3459 POE CTLR	 SI3459BDV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 60V 2.9A 6- TSOP	 SI3459BDY-T1-E3 VISHAY SI3459BDY-T1-E3 VISHAY
 SI3459DV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 2.2A 6- TSOP	 SI3459-B02-IMR Energy Micro (Silicon Labs) IC POE PSE 8 PORT 802.3AT 56QFN	 SI3459BDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 2.9A 6- TSOP	 SI3459BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 2.9A 6- TSOP

heiße Teile

Mehr

 SI3457BDV-T1-E3	 SI3457BDV-T1-E3	 SI3457BDV-T1-GE3	 SI3457BDV-T1-GE3	 SI3457CDV-T1-E3
 SI3457CDV-T1-E3	 SI3457CDV-T1-GE3	 SI3457CDV-T1-GE3	 SI3457DV	 SI3457DV
 SI3457DV-T1	 SI3457DV-T1-E3	 SI3457DV-T1-GE3	 SI3457DV-T1-E3	 SI3458BDV-T1-E3
 SI3458BDV-T1-E3	 SI3458BDV-T1-GE3	 SI3458BDV-T1-E3	 SI3458DV-T1-E3	 SI3458DV-T1-E3
 SI3458DV-T1-GE3	 SI3459BDV-T1-E	 SI3459BDV-T1-E3	 SI3459BDV-T1-E3	 SI3459BDV-T1-GE3
 SI3459DV-T1-E3	 SI3459DV-T1-E3	 SI3459DV-T1-GE3	 SI3460-E02-GMR	 SI3460-E03-GMR
 SI3460BDV-T1-E3	 SI3460BDV-T1-E3	 SI3460BDV-T1-GE3	 SI3460BDV-T1-GE3	 SI3460DDV
 SI3460DDV-T1-GE3	 SI3460DDV-T1-GE3	 SI3460DV	 SI3460DV-T1	 SI3460DV-T1-E3
 SI3460DV-T1-E3	 SI3460DV-T1-GE3	 SI3460DV-T1-GE3	 SI3461DV-T1-E3	 SI3461DVT1-GE3
 SI3464DV	 SI3464DV-T1-GE3	 SI3464DV-T1-GE3	 SI3465DV-T1-E3	 SI3465DV-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited